

修改意见

▼ 修改意见

- 1、译文出处
- 2、题目
- 3、红色字要删除
- 4、图和表的上下要空一行
- 5、图和表的题注要比正文小一号
- 6、没有加页码
- 7、图和表的下面不要留三行 及 以上空白
- 8、图和题注不要分开在两页
- 9、题注可以修改前后缩进来使得其与正文段落格式区分开
- 10、参考文献格式如我上次所说

1、译文出处

译文出处：

J. °Y. °Park °et °al., °Revival °of °Ferroelectric °Memories °Based °on °Emerging °
Fluorite-Structured °Ferroelectrics. °Adv °Mater, °e2204904 °(2022)°

中间的小圈

2、题目



院 系 光学与电子信息学院

专业班级 电子 1903

姓 名 裴玉战

学 号 U201914184

指导教师 王兴晟



这个我感觉内容都在横线的中间比较好吧，但是可能也不用改

3、红色字要删除

译文要求 (封面、封底用浅蓝色封面纸 (卡纸) 打印，此面为封面背面)

4、图和表的上下要空一行

一般我会空

- 5、图和表的题注要比正文小一号
- 6、没有加页码
- 7、图和表的下面不要留三行 及 以上空白

正交相的晶体结构方案。(b)在 500 kHz 频率下测量的 Pt/HZO (1.5 nm) /NSTO 电容器的极化电场曲线。文献中不同厚度的(c)剩余极化 (Pr) 和(d)强制场 (Ec) 值的变化总结。

表 2. 钙钛矿和萤石结构铁电体的晶体结构和性质的比较

8、图和题注不要分开在两页

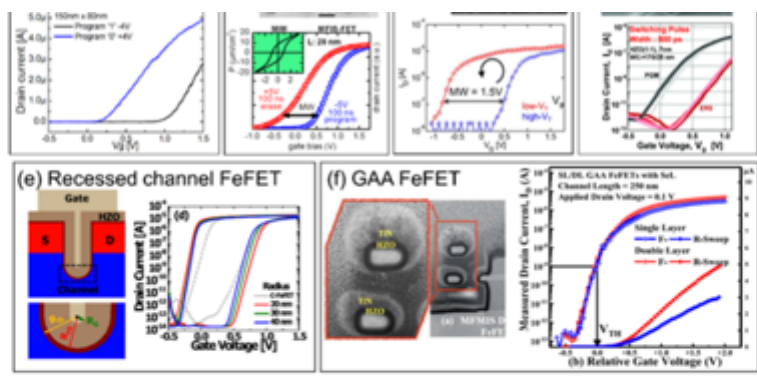


图 4.(a)第一个铁电 Si:HfO_2 -FeFET,(b)-28-nm 通道长度 FeFET,(c)-22-nm 技术节点 FDSOI,(d)-25-nm FinFET,(e)凹槽通道 FeFET,(f)门全能 FeFET。其中包括横断面透射电镜图像(图 a-d 的上方和图 f 的左方)、设备方案(图 e 的左方),以及栅极电压-漏极电流传递曲线(图 a-d 的下方和图 e 和 f 的右方)

9、题注可以修改前后缩进来使得其与正文段落格式区分开

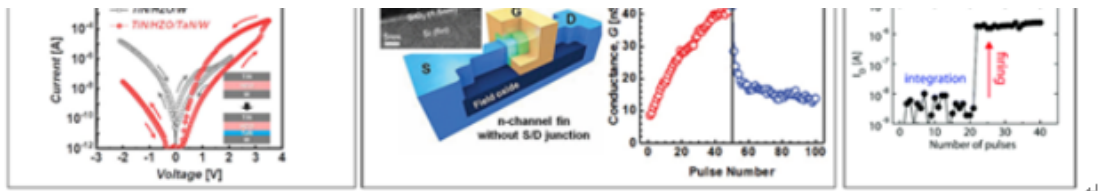


图 7.(a) (上方) TiN/HZO/TaN/W 铁电隧道结结构示意图及 TEM 图像；(中间)在增强的情况下，使用方案 1、2、3 测量电导作为脉冲数的函数，读取电压为 1V；(下方) TiN/HZO/W 和 TiN/HZO/TaN/W 堆栈 FTJ 的 I-V 曲线，显示了 TiN/HZO/TaN/W-FTJ 器件的自整流特性。(b) (左方) 绝缘子上硅上的 Fe-SBFET 结构示意图及其电导随输入脉冲数的变化；(右方) Fe-SBFET 中的电荷分布示意图，这取决于输入脉冲的数量及其能带图；- (c)-TiN/HZO (8.5 nm) /SiO₂/Si 结构 FinFET 方案及其 TEM 图像。左侧显示了扫描电压在 1.2V 和 1.5-V 的读数范围内的 FinFET 的增强和抑制特性。(d) (上方) 通道长度和宽度分别为 30 nm 和 80 nm 的器件的横断面 TEM 图像；“G”、“D”和“S”分别表示栅极、漏极和源极终端。(中间)在 OFF 状态下进行积累的脉冲方案由一系列具有振幅 V_p 和持续时间 t_p 的相同脉冲组成。(下方)在 $V_p=2.2\text{ V}$ ， $t_p=1\text{ }\mu\text{s}$ 状态下使 I_D 从 OFF 变为 ON。

如图可以修改其段落前后各自缩进三个字符，这样可以与正文段落区分开，否则看着很不清晰

10、参考文献格式如我上次所说

[37] a) K.-Y. H. C.-Y. Liao, Z.-F. Lou, H.-C. Tseng, C.-Y. Lin, Z.-X. Li, F.-C. Hsieh, C.-C. Wang, F.-S. Chang, W.-C. Ray, Y.-Y. Tseng, S.-T. Chang, T.-C. Chen, M.-H. Lee., *IEEE 2022 Symposium on VLSI Technology & Circuits Digest of Technical Papers* **2022**, 393; b) G. Pahwa, P. Kushwaha, A. Dasgupta, S. Salahuddin, C. Hu, *IEEE Trans. Electron Devices* **2021**, 68, 4223; c) K. Lee, J.-H. Bae, S. Kim, J.-H. Lee, B.-G. Park, D. Kwon, *IEEE Electron Device Lett.* **2020**, 41, 1201; d) S.-Y. Lee, C.-C. Lee, Y.-S. Kuo, S.-W. Li, T.-S. Chao, *IEEE J. Electron Devices Soc.* **2021**, 9, 236. ↵

[38] a) C.-Q. Luo, C.-Y. Kang, Y.-L. Song, W.-P. Wang, W.-F. Zhang, *Appl. Phys. Lett.* **2021**, 119, 042902; b) U. Schroeder, C. Richter, M. H. Park, T. Schenk, M. Pesic, M. Hoffmann, F. P. Fengler, D. Pohl, B. Rellinghaus, C. Zhou, *Inorganic chemistry* **2018**, 57, 2752; c) J. Müller, U. Schröder, T. Böske, I. Müller, U. Böttger, L. Wilde, J. Sundqvist, M. Lemberger, P. Kücher, T. Mikolajick, *J. Appl. Phys.* **2011**, 110, 114113; d) M. Hoffmann, U. Schroeder, T. Schenk, T. Shimizu, H. Funakubo, O. Sakata, D. Pohl, M. Drescher, C. Adelman, R. Materlik, *J. Appl. Phys.* **2015**, 118, 072006; e) T. Schenk, S. Mueller, U. Schroeder, R. Materlik, A. Kersch, M. Popovici, C. Adelman, S. Van Elshocht, T. Mikolajick, presented at *2013 Proceedings of the European Solid-State Device Research Conference (ESSDERC)*, **2013**; f) P. Polakowski, J. Müller, *Appl. Phys. Lett.* **2015**, 106, 232905; g) J.-D. Luo, Y.-Y. Lai, K.-Y. Hsiang, C.-F. Wu, Y.-T. Yeh, H.-T. Chung, Y.-S. Li, K.-C. Chuang, W.-S. Li, C.-Y. Liao, *IEEE Trans. Electron Devices* **2021**, 68,